Люминесценция ионов TI⁺ в кристалле KZnF₃

© Л.К. Аминов, С.И. Никитин, Н.И. Силкин, Р.В. Юсупов

Казанский государственный университет, 420008 Казань, Россия E-mail: Nikolai.Silkin@ksu.ru

Приводятся результаты исследований спектров люминесценции кристаллической системы KZnF₃: Tl⁺ в интервале энергий 4.75–5.9 eV при температурах 10–300 K и возбуждении в *A*-полосу поглощения (5.7–6.3 eV). При 300 K наблюдалась интенсивная полоса люминесценции с максимумом при 5.45 eV, соответствующая одиночным ионам Tl⁺, замещающим позицию K⁺. При *T* < 20 K наблюдается интенсивная узкая линия с энергией 5.723 eV, которую мы приписываем бесфононному переходу ${}^{3}\Gamma_{1u} - {}^{1}\Gamma_{1g}$, слабо разрешенному за счет сверхтонкого взаимодействия. Исследовалась также кинетика распада люминесценции в зависимости от температуры.

Основные характеристики спектра люминесценции удовлетворительно описываются в рамках стандартной полуклассической теории, основанной на принципе Франка–Кондона и эффекте Яна–Теллера для возбужденной *sp*-конфигурации иона Tl⁺ с использованием набора параметров, полученных нами ранее при описании спектров поглощения изучаемой системы.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 98-02-18037) и научно-образовательного центра КГУ REC-007.

Фторидные кристаллы со структурой перовскита, активированные ионами переходных металлов, являются перспективными материалами для твердотельных перестриваемых лазеров ближнего ИК-диапазона [1-3]. Сравнительно недавно было показано, что кристаллы КМgF₃:Tl⁺ являются хорошими сцинтилляторами [4], Активированные редкоземельными ионами фторидные кристаллы (например, LiCaAlF₆: Ce³⁺) благодаря их широкой области прозрачности находят применение в качестве активных сред перестраиваемых лазеров УФ-диапазона [5]. В работе [6] сообщалось о получении усиления в видимой и УФ-области на кристалле CsI:In(Tl). В этой связи исследования фторидных кристаллов, активированных ртутеподобными ионами, с целью выяснения их перспективности для лазеров УФ-диапазона являются актуальной задачей.

Первые исследования спектров поглощения и фотолюминесценции кристаллов $KMgF_3:Tl^+$ [7–9] выявили сходство этих систем с хорошо изучеными ранее щелочногалоидными кристаллами с примесью ртутеподобных ns^2 -ионов. Такие системы исследовались очень подробно и экспериментально, и теоретически начиная с 30-х годов прошлого столетия; результаты исследований суммированы в ряде известных обзоров (см., например, [10,11]). Поэтому теоретический анализ оптических спектров рассматриваемых нами систем можно проводить, используя хорошо разработанные методики. Так, рассчитанные формы *A*-полос поглощения ионов Tl⁺ в кристаллах KZnF₃ и KMgF₃ в диапазоне температур 10–300 K удовлетворительно согласовались с результатами экспериментальных исследований [12].

В настоящей работе приводятся основные результаты исследований люминесценции ионов Tl^+ в кристалле $KZnF_3.$

1. Экспериментальные результаты

Кристаллы KZnF₃, активированные ионами Tl⁺, были выращены методом Бриджмена–Стокбаргера аналогично [12]. Концентрация ионов Tl⁺ в исследуемых образцах составляла 0.5 wt.% по шихте.

Спектры люминесценции и возбуждения были измерены при возбуждении ксеноновой лампой ДКсЭл-1000 с помощью монохроматоров МДР-6 (в канале возбуждения) и МДР-23 (в канале регистрации), измеренные спектры на аппаратную функцию не корректировались. При измерении кинетики люминесценции возбуждение осуществлялось лампой ДКСШ-150, работающей в импульсном режиме (длительность импульса ~ 30 ns), для регистрации люминесценции использовался ФЭУ-106, работающий в режиме счета фотонов ("мертвое" время системы регистрации составляло 0.2μ s). При измерениях в области температур 4.2-300 К был использован криостат CF-1204 фирмы Oxford–Instruments.

При возбуждении в *A*-полосу поглощения кристалла $KZnF_3:Tl^+$ (рис. 1, *a*) при T = 300 K наблюдается интенсивная полоса люминесценции с максимумом 5.45 eV (рис. 1, *b*). Спектр возбуждения данной полосы люминесценции практически совпадает со спектром *A*-полосы поглощения. Этот факт позволяет сделать вывод о том, что полоса люминесценции с максимумом на 5.45 eV обусловлена одиночными ионам Tl^+ .

При понижении температуры до 10 К в спектре люминесценции проявляется интенсивная бесфононная линия с энергией 5.723 eV (рис. 2). Анализ колебательной структуры позволяет выделить колебания с частотами 115 и 300 сm⁻¹, находящимися в хорошем согласии с эффективными частотами фононов мод Γ_5 и Γ_3 в основном состоянии, использованными нами в [12] при моделировании спектра поглощения кристалла KZnF₃:Tl⁺.



Рис. 1. Спектры поглощения (a) и люминесценции (b) кристалла KZnF₃ : Tl⁺ при T = 300 K.



Рис. 2. Спектры люминесценции кристалла $KZnF_3:Tl^+$ при температурах 10, 68 и 124 К.



Рис. 3. Температурная зависимость времени жизни "медленной" компоненты люминесценции кристалла $KZnF_3:Tl^+$ при возбуждении в *A*-полосу поглощения, а также ее аппроксимация зависимостями (1) — *a* и (1), (9) — *b*. На вставке показана схема уровней энергии, использованная при анализе экспериментальных данных.

С целью определения энергетической структуры возбужденного состояния ионов Tl⁺ в исследуемом кристалле были выполнены измерения кинетики люминесценции. Были выявлены две характерные для ртутеподобных ионов компоненты люминесценции — быстрая и медленная [11]. Температурная зависимость времени жизни для медленной компоненты $\tau_{\rm s}(T)$ приведена на рис. 3. Анализ этой зависимости, как будет показано в разделе 2, можно проводить в рамках обычной трехуровневой модели [11], схематически изображенной на рис. 3. Для данной системы уровней люминесценция может быть обусловлена как переходами с уровня 2 непосредственно после возбуждения (быстрая компонента), так и переходами из состояний 2 и 3 после их термализации (медленная компонента). Вклады переходов из этих состояний в стационарные спектры люминесценции зависят от вероятностей переходов k₁, k_2, k_{12}, k_{21} и энергетического зазора между ними ΔE (рис. 3). Здесь k_1, k_2 — скорости излучательных переходов из состояний 1, 2 в основное, а k_{21}, k_{12} — скорости безызлучательных переходов между уровнями 1 и 2.

При обычно выполняющихся условиях $k_1 \ll k_2 \ll k_{21}$ [11] температурная зависимость времени жизни медленной компоненты (τ_s) определяется следующим выражением:

$$\frac{1}{\tau_s} = \frac{k_1 + g k_2 \exp(-\Delta E/kT)}{1 + g \exp(-\Delta E/kT)},$$
(1)

где g — отношение кратностей вырождения релаксированных возбужденных состояний 2 и 1 (g = 2, см. далее) и ΔE — энергетический зазор между этими состояниями. В области низких температур (10 K) время жизни медленной компоненты люминесценции определяется только вероятностью k_1 , в кристалле KZnF₃: Tl⁺ $k_1 = 85 \text{ s}^{-1}$. При аппроксимации экспериментальных данных были получены следующие величины параметров: $k_2 = (7.1 \pm 0.1) \cdot 10^7 \text{ s}^{-1}$ и $\Delta E = 0.146 \pm 0.002 \text{ eV}$, Перейдем к обсуждению полученных результатов.

2. Обсуждение результатов

Спектры люминесценции, кинетика люминесценции примесных s^2 -ионов в кристаллических матрицах, как и спектры поглощения этих центров, вполне удовлетворительно описываются в рамках полуклассической теории, в основе которой лежит принцип Франка–Кондона и эффект Яна–Теллера в возбужденной *sp*-конфигурации [10,11]. Во многих случаях, к которым относятся и изучаемые в настоящей работе системы, примесные центры в основном состоянии обладают кубической симметрией. При этом 12 состояний возбужденной *sp*-конфигурации центра с учетом кулоновского взаимодействия электронов, кубического кристаллического поля и спин-орбитального взаимодействия распределяются по четырем уровням — $E_1({}^3\Gamma_{1u})$, $E_A({}^3\Gamma_{4u}^*)$, $E_B({}^3\Gamma_{3u}+{}^3\Gamma_{5u})$, $E_C({}^1\Gamma_{4u}^*)$ в порядке возрастания энергии.

Здесь Γ_{α} — индексы неприводимых представлений группы октаэдра O_h , по которым преобразуются состояния, относящиеся к указанным уровням, а верхний индекс при Γ_{α} указывает мультиплетность спиновых составляющих электронных состояний. Состояния ${}^{3}\Gamma_{4u}^{*}$, ${}^{1}\Gamma_{4u}^{*}$ перемешиваются спин-орбитальным взаимодействием, что отмечается звездочкой в их обозначениях.

При учете смещения атомов из равновесных положений к электронной энергии примесного центра добавляется упругая энергия (H_L) и энергия электронно-колебательного взаимодействия (H_{eL}) . Последняя обычно рассматривается в линейном по смещениям решетки приближении и записывается в виде

$$H_{\rm el}^{(1)} = \sum_{i=1-6} V_i Q_i,$$
 (2)

где Q_i — "моды взаимодействия", представляющие собой некоторые линейные комбинации смещений атомов решетки, преобразующиеся при поворотах и отражениях согласно неприводимым представлениям группы симметрии центра: $\Gamma_{1g}(Q_1)$, $\Gamma_{3g}(Q_2, Q_3)$ и $\Gamma_{5g}(Q_4, Q_5, Q_6)$. Для рассмотрения только одной возбужденной *sp*-конфигурации ограничение шестью модами взаимодействия в $H_{\rm el}^{(1)}$ является строгим; учет квадратичных по смещениям Q_1 членов электронно-колебательного взаимодействия записи гамильтониана взаимодействия и матрицы энергии. Вид матрицы $(H_{\rm el}^{(1)} + H_{\rm el}^{(2)})$ с исправлением некоторых неточностей, встречающихся в литературе при написании матрицы $H_{\rm el}^{(1)}$, приведен в нашей предыдущей работе [12].

Упругая энергия, соответствующая модам взаимодействия, в основном состоянии обычно записывается в виде

$$H_L^{(g)} = \sum Q_i^2, \tag{3}$$

что подразумевает определенный выбор размерности "координат" Q_i и их масштаба, который может быть разным для трех типов колебаний Γ_{1g} , Γ_{3g} и Γ_{5g} , поскольку эффективные частоты (ω_i) этих колебаний не обязаны быть одинаковыми. В возбужденной конфигурации

$$H_L^{(\text{exc})} = a_1 Q_1^2 + a_2 (Q_2^2 + Q_3^2) + a_3 (Q_4^2 + Q_5^2 + Q_6^2), \quad (4)$$

где коэффициенты a_1 , a_2 , a_3 учитывают возможное отличие эффективных частот в основной и возбужденной конфигурациях.

При учете $H_{el}^{(1)}$ и $H_L^{(exc)}$ возбужденные уровни E_A , E_B , E_C расщепляются, и возникает 12 поверхностей адиабатических потенциалов $E_n(Q_1, \ldots, Q_6)$. Минимумы этих потенциалов представляют собой "релаксированные возбужденные состояния", в которые после тепловой релаксации переходят центры, возбужденные излучением из основного состояния при сравнительно небольших значениях Q_i

$$\langle Q_i^2 \rangle \approx kT_i^*/2 = (\hbar\omega/4) \coth(\hbar\omega/2kT).$$
 (5)

Обычная люминесценция связана с переходами в основное состояние из релаксированных возбужденных состояний. Появление нескольких полос люминесценции связывается с тем, что после возбуждения оптические центры релаксируют в различные минимумы. В щелочно-галоидных кристаллах при возбуждении в А-полосу наблюдаются одна или две полосы А_T и А_X, первая из которых соответствует центрам с тетрагональной симметрией. Сосуществование двух типов минимумов на нижних поверхностях адиабатического потенциала $E_1(Q_1, \ldots, Q_6), E_A(Q_1, \ldots, Q_6)$ иллюстрируется путем рассмотрения сечений этих поверхностей $E(Q_2, Q_3)$ при остальных $Q_i = 0$ [10,11]. Результаты рассмотрения удовлетворительно описывают эксперимент, если в электронно-колебательном взаимодействии преобладает связь с тетрагональными модами $Q_2, Q_3,$ когда велик параметр $b = \langle p_x | V_2 | p_x \rangle$ (p_x — возбужденная молекулярная орбиталь, подобная атомной 6*p*_x-функции).

Анализ спектров поглощения в системах KMgF₃: Tl⁺ и KZnF₃: Tl⁺ показал, что в них преобладает взаимодействие с тригональными модами Q_4, Q_5, Q_6 : $c^2 \gg b^2$, где $c = \langle p_y | V_4 | p_z \rangle$ [8,12]. В этом случае естественно исследовать в качестве основного приближения минимумы функций $E(Q_4, Q_5, Q_6)$ и систему эквипотенциальных поверхностей $E(Q_4, Q_5, Q_6) = \text{const.}$ Отметим, что если функции $E(Q_2, Q_3) = \text{const}$ на плоскости Q_2, Q_3 обладают тригональной симметрией C_{3v} , то поверхности $E(Q_4, Q_5, Q_6) = \text{const}$ обладают симметрией тетраэдра T_d в трехмерном Q_4 -, Q_5 -, Q_6 -пространстве (инверсия в обычном пространстве оставляет точки (Q_4, Q_5, Q_6) неизменными, повороты четвертого порядка C_4, S_4 представляются в Q-пространстве зеркальным поворотом S_4 с осью Q_4, Q_5 или Q_6 и т.д.).

Мы провели такие расчеты для KZnF₃:Tl⁺, используя полученные в предыдущей работе [12] параметры матрицы энергии возбужденной *sp*-конфигурации примесного центра иона Tl⁺: средние положения полос поглощения $E_A = 6.03 \text{ eV}, E_B = 7.2 \text{ eV}, E_C = 8.14 \text{ eV};$ в дополнение к этому мы взяли в качестве невозмущенной энергии нижнего уровня этой конфигурации $E_1({}^{3}\Gamma_{1u}) = 5.72 \text{ eV},$ что приближенно совпадает с положением бесфононной линии излучения. Параметры электронно-колебательного взаимодействия (в eV)

$$b^2 = 0.49$$
, $b'^2 = 0.25$, $c^2 = 1.69$, $c'^2 = 1$.

При ограничении тригональными искажениями центра Q_4 , Q_5 , Q_6 параметры b, b' в расчеты, разумеется, не входят. Параметр, определяющий степень перемешивания состояний спин-орбитальным взаимодействием, $R = \mu^2 / \nu^2 = 7$. Упругие константы a_i в (4) считались равными единице.

Приведем некоторые результаты вычислений уровней энергии E_n *sp*-конфигурации центра Tl^+ как функций смещений Q_4, Q_5, Q_6 этого центра из равновесного кубического расположения. Мы полагали $Q_4 = mQ, Q_5 = nQ, Q_6 = kQ$ с $Q^2 = Q_4^2 + Q_5^2 + Q_6^2$, так что коэффициенты *m*,



Рис. 4. Адиабатические потенциалы возбужденных состояний ${}^{3}\Gamma_{1u}$ и ${}^{3}\Gamma_{4u}^{*}$.

n, k являются направляющими косинусами в пространстве (Q_4, Q_5, Q_6).

На рис. 4 представлен спектр триплета ${}^{3}\Gamma_{4u}^{*}$ и синглета ³Г_{1и} в виде функции величины тригональной деформации Q, определяемой направлением m = n = k. Триплет ${}^{3}\Gamma_{4u}^{*}$ расщепляется на синглет и дублет, и минимальная энергия дублета при Q = -0.67 примерно соответствует абсолютному минимуму функции $E_A(Q_1,\ldots,Q_6) \approx 5.88 \,\mathrm{eV}$. Основное оптически неактивное состояние *sp*-конфигурации ${}^{3}\Gamma_{1u}$ обладает слабо выраженным минимумом энергии $E_1(Q = 0) = 5.72 \,\text{eV};$ при температурах ~ 100 K (0.01 eV) флуктуации деформации комплекса, ответственные за уширение линии запрещенного перехода ${}^{3}\Gamma_{1u} \rightarrow {}^{1}\Gamma_{1e}$, достигают значения $\sqrt{\langle Q^2 \rangle} \approx 0.4$. Таким образом, приближенно анализ люминесценции можно проводить на основе трехуровневой модели рис. 3, где второй возбужденный уровень — тригональный дублет, возникающий при расщеплении исходного кубического триплета ${}^{3}\Gamma_{4\nu}^{*}$. Расчетный интервал между возбужденными уровнями $\Delta E = E_A(Q_{\min}) - E_1 \approx 0.16 \,\mathrm{eV}$ удовлетворительно соответствует результатам эксперимента (0.146 eV).

Картину люминесценции одиночных Tl⁺-центров теперь можно представить следующим образом. Возбуждение центров происходит в сравнительно небольшой области значений Q, соответствующих флуктуациям деформаций в основном состоянии в пределах $Q^2 \leq kT^*$, где T^* выражается, как указано выше, через эффективную частоту, связываемую с деформациями типа Γ_{5g} в основном состоянии ${}^1\Gamma_{1g}$ ($\omega \approx 100 \,\mathrm{cm}^{-1}$). При возбуждении в *A*-полосу заселяются состояния триплета ${}^3\Gamma_{4u}^*$ с энергиями вблизи 6.03 eV. В результате деформации возбужденного комплекса оптические центры релаксируют в указанное на рисунке состояние с минимумом энергии триплета, откуда часть центров совершает дипольно-разрешенный (быстрый) люминесцентный переход в основное состояние. Другая часть центров за счет электронно-колебательного взаимодействия переходит в синглетное состояние ${}^{3}\Gamma_{1u}$ и в результате обратной деформации вновь скатывается в точку Q = 0 пространства Q_4, Q_5, Q_6 , соответствующую минимуму энергии синглета. Излучательный переход с энергиями 5.72 eV из этого состояния разрешен лишь за счет некоторых слабых взаимодействий. Переход же из триплетного состояния сдвинут в сторону меньших энергий, $E_{\min}(Q = -0.67) - Q^2 = 5.43$ eV, что неплохо согласуется с наблюдаемым положением полосы люминесценции при температурах порядка 100 K, когда люминесценция обусловлена в основном переходами из состояния ${}^{3}\Gamma_{4u}^{*}$.

При температуре $\leq 10 \, \text{K}$ центры сосредоточиваются в непосредственной окрестности минимума состояния ${}^{3}\Gamma_{1u}$, и бесфононная линия $({}^{3}\Gamma_{1u} \rightarrow {}^{1}\Gamma_{1g})$, соответствующая переходу между двумя минимумами, имеет очень малую ширину и значительную пиковую интенсивность (рис. 2). С ростом температуры флуктуации Q, как уже отмечалось, быстро нарастают, "бесфононная" линия уширяется и пик ее сдвигается в сторону более низких частот; при T ~ 100 K оценочная ширина линии достигает величины порядка $Q^2 \sim 0.16 \,\mathrm{eV}$, и бесфононная линия перестает наблюдаться. Кроме того, с ростом температуры быстро растет вероятность обратных электронно-колебательных переходов ${}^{3}\Gamma_{1u} \rightarrow {}^{3}\Gamma_{4u}^{*}$, что приводит к уменьшению и интегральной интенсивности "запрещенной" линии ${}^{3}\Gamma_{1u} \rightarrow {}^{1}\Gamma_{1g}$. "Медленная" люминесценция теперь — не прямой переход ${}^{3}\Gamma_{1u} \rightarrow {}^{1}\Gamma_{1e}$, а высвечивание центров, попавших после возбуждения в метастабильное состояние ${}^{3}\Gamma_{1u}$, через активный уровень ${}^{3}\Gamma_{4u}^{*}$, так что скорость такого процесса главным образом определяется скоростью перехода с поглощением фононов ${}^3\Gamma_{1u} \rightarrow {}^3\Gamma_{4u}$, приблизительно экспоненциально зависящей от обратной температуры, $k_{12} = k_{21} \exp(-\Delta E/kT)$, где ΔE — усредненный интервал между уровнями $E_1({}^3\Gamma_{1u}), E_A({}^3\Gamma_{4u}^*)$ (ср. с (1)).

Полоса люминесценции ${}^{3}\Gamma_{4u}^{*} \rightarrow {}^{1}\Gamma_{1g}$ обладает заметной шириной даже при очень низких температурах. Поскольку начальное состояние соответствует минимуму энергии при |Q| = -0.67, конечное состояние отвечает крутому участку параболоида, изображающего адиабатический потенциал основного состояния ${}^{1}\Gamma_{1a}$, и небольшие флуктуации δQ , имеющиеся при любой температуре, приводят к существенному разбросу конечных энергий и заметной ширине полосы. С ростом температуры флуктуации увеличиваются, центры излучения в возбужденном состоянии занимают все возрастающую область в пространстве Q_4, Q_5, Q_6 (в основном при больших Q), полоса уширяется и максимум ее сдвигается в сторону более низких частот, поскольку с ростом Q в пределах $\delta Q \sim kT$ интервал $E_A({}^3\Gamma_{4u}^*, Q) - E({}^1\Gamma_{1a})$ уменьшается.

Запрещенный в электродипольном приближении переход ${}^{3}\Gamma_{1u} \rightarrow {}^{1}\Gamma_{1g}$ разрешается, например, при учете примешивания к ${}^{3}\Gamma_{1u}$ -состоянию ${}^{3}\Gamma_{4u}^{*}$ - и ${}^{1}\Gamma_{4u}^{*}$ -состояний посредством сверхтонкого взаимодействия, главный вклад в которое составляет контактное взаимодействие 6*s*электрона иона Tl⁺ со спином его ядра. Этот механизм рассматривался ранее в работах [13,14]. Гамильтониан сверхтонкого взаимодействия имеет вид [15]

$$H_{nf} = g_{S} \mu_{B} \gamma_{n} I \cdot N$$

= $\sum \left\{ (1-s)/r^{3} + 3r(s \cdot r)/r^{5} + (8\pi/3)s\delta(r) \right\}, (6)$

и его матричный элемент между состояниями ${}^{3}\Gamma_{1u}$ и ${}^{1}\Gamma_{4u}^{*}$ отличен от нуля. Например (выпишем здесь лишь контактный вклад)

$$\langle {}^{1}\Gamma_{4u}, z | N_{z}(\text{cont}) | {}^{3}\Gamma_{4u} \rangle$$

$$= (8\pi/3\sqrt{6}) \langle Z_{+} | \delta(r) | Z_{-} \rangle \langle S_{0} | s_{Z} | S_{Z} \rangle$$

$$= (8\pi/3\sqrt{6}) R_{6s}^{2}(0),$$

$$(7)$$

где $|Z_{\pm}\rangle = (1/\sqrt{2})(|sp_Z\rangle \pm |p_Zs\rangle), |s\rangle, |p_Z\rangle$ — одночастичные 6s-, 6p_z-орбитали, R_{6s}, R_{6p} — их радиальные части, $|S_{0,Z}\rangle = (1/\sqrt{2})(|1/2, -1/2\rangle - |-1/2, 1/2\rangle)$ — спиновые функции [11]. Эффективная величина A сверхтонкого взаимодействия для иона Tl⁺ ($H_{hf} = AI \cdot S$) составляет величину порядка $1-3 \,\mathrm{cm}^{-1}$ (см., например, [13]), и вероятность излучения из метастабильного уровня можно оценить как

$$w({}^{3}\Gamma_{1u}) \approx \left[A/(E_{A}-E_{1}) \right]^{2} \cdot w({}^{3}\Gamma_{4u}^{*}) \sim 10^{-6} \cdot w({}^{3}\Gamma_{4u}^{*}), \quad (8)$$

что приблизительно совпадает со следующим из измерений кинетики люминесценции отношением скоростей излучательных переходов k_1/k_2 .

Выше уже отмечалось, что температурная зависимость медленной компоненты люминесценции неплохо описывается формулой (1) (рис. 3, *a*). Заметное расхождение с экспериментом наблюдается на изломе графика, при температурах 20 < T < 140 К. Возможно, что в этой области температур становится существенным другой механизм разрешения переходов из состояния ${}^{3}\Gamma_{1u}$, за счет взаимодействия электронов с либрационными Γ_{4g} -колебаниями [16]. Этот механизм приводит к температурной зависимости скорости излучательного перехода, и коэффициент k_1 в (1) можно представить в виде суммы двух вкладов

$$k_1(T) = k_{10} + k_{1d} \coth(\hbar\omega/2kT),$$
 (9)

где ω — частота Γ_{4g} -моды. Введение дополнительных параметров позволяет хорошо описать зависимость $\tau_s(T)$ во всем температурном диапазоне (рис. 3, *b*), однако сама оценка параметров k_{10} , k_{1d} , ω становится менее определенной.

Отметим в заключение, что нами также были выполнены исследования оптических свойств кристаллов $KMgF_3:Tl^+$. И если результаты наших измерений A-полосы поглощения [12] в основном совпали с результатами предыдущих исследований этой системы [7,8], то в спектрах люминесценции при низких температурах в отличие от сообщенных ранее результатов [9] была обнаружена интенсивная бесфононная линия. Результаты этих исследований и их теоретическая интерпретация в настоящее время готовятся к публикации.

Список литературы

центров.

- М.В. Митягин, С.И. Никитин, Н.И. Силкин, А.П. Шкадаревич, Ш.И. Ягудин. Изв. АН СССР. Сер. физ. 54, 6, 1512 (1990).
- [2] K.R. German, U. Durr, W. Kunzel. Opt. Lett. 11, 12 (1986).
- [3] L.F. Johnson, H.J. Guggenheim, D. Bahnek, A.M. Johnson. Opt. Lett. 8, 371 (1983).
- [4] C. Furetta, C. Bacci, B. Rispoli, C. Sanipoli, A. Scacco. Radiat. Protect. Dosim. 33, 107 (1990).
- [5] M.A. Dubinskii, V.V. Semashko, A.K. Naumov, R.Yu. Abdulsabirov, S.L. Korableva. J. Mod. Opt. 40, 1, 1 (1993).
- [6] G.P. Pazzi, M.G. Baldecchi, P. Fabeni, R. Linari, A. Ranfagni. Optics Communications 43, 12, 405 (1982).
- [7] A. Scacco, S. Fioravanti, M, Missori, U.M. Grassano, A. Luci, M. Palummo, E. Giovenale, N. Zema. Phys. Chem. Solid. 54, 1035 (1993).
- [8] T. Tsuboi, A. Scacco. J. Phys. Condens. Matter 7, 9321 (1995).
- [9] A. Scacco, S. Fioravanti, U.M. Grassano, N. Zema, M. Nikl, E. Mihokova, V. Hamplova. Phys. Chem. Solid. 55, 1–7 (1994).
- [10] A. Ranfagni, P. Mugnai, M. Bacci, G. Vikiani, M.P. Fontana. Adv. Phys. **32**, 905 (1983).
- [11] P.W.M. Jacobs. J. Phys. Chem. Solid. 52, 35 (1991).
- [12] L.K. Aminov, A.V. Kosach, S.I. Nikitin, N.I. Silkin, R.V. Yusupov. J. Phys.: Condens. Matter 13, 6247 (2001).
- [13] Y. Merle d'Aubigne. Le Si Dang. Phys. Rev. Lett. 43, 14, 1023 (1979).
- [14] А.Ф. Эллервеэ, А.И. Лайсаар, А.-М.А. Опер. Письма в ЖЭТФ **33**, 24 (1981).
- [15] А. Абрагам, Б. Блини. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов. Мир, М. (1972).
- [16] S. Asano. Phys. Stat. Sol. (b) 105, 613 (1981).